

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2018년 2월 22일 (22.02.2018)



(10) 국제공개번호

WO 2018/034532 A1

(51) 국제특허분류:
C01B 32/956 (2017.01)

(21) 국제출원번호: PCT/KR2017/009002

(22) 국제출원일: 2017년 8월 18일 (18.08.2017)

(25) 출원언어: 한국어

(26) 공개언어: 한국어

(30) 우선권정보:
10-2016-0104726 2016년 8월 18일 (18.08.2016) KR

(71) 출원인: 주식회사 티씨케이 (TOKAI CARBON KOREA CO., LTD) [KR/KR]; 17602 경기도 안성시 미양면 개성산업단지로 71, Gyeonggi-do (KR).

(72) 발명자: 김정일 (KIM, Joung Il); 17834 경기도 평택시 세교공원로 33, 303동 702호 (세교동, 부영원앙아파트), Gyeonggi-do (KR).

(74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW FIRM); 06044 서울시 강남구 학동로 3길 9, 5층 (논현동, 명림빌딩), Seoul (KR).

(81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,

SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

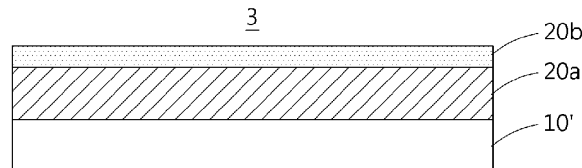
공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: SiC MATERIAL AND SiC COMPOSITE MATERIAL

(54) 발명의 명칭: SiC 소재 및 SiC 복합 소재

[도1c]



(57) Abstract: The present invention relates to an SiC material and an SiC composite material and, more particularly, to an SiC material and an SiC composite material having a diffraction intensity ratio (I) of an X-ray diffraction peak, calculated by formula 1 down below, of less than 1.5. The present invention can provide an SiC material and an SiC composite material which can be etched evenly when exposed to plasma and thereby reduce the occurrence of cracks, holes and so forth. [Formula 1] Diffraction intensity ratio (I) = (peak intensity of plane (200) + peak intensity of plane (220)) / peak intensity of plane (111)

(57) 요약서: 본 발명은, SiC 소재 및 SiC 복합 소재에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 하기의 식 1에 따라 계산되는 X-회절 피크의 회절 강도비(I)가 1.5 미만인 SiC 소재 및 SiC 복합 소재에 관한 것이다. 본 발명은, 플라즈마에 노출 시 균일하게 식각되어 크랙, 홀 등의 발생을 낮출 수 있는 SiC 소재 및 SiC 복합 소재를 제공할 수 있다. [식 1] 회절 강도비(I)=(200)면 피크 강도 + (220)면의 피크 강도/(111)면의 피크 강도



WO 2018/034532 A1